#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



#### (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Juni 2005 (30.06.2005)

### **PCT**

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/060096 A1

von US): ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG [DE/DE]; Mühldorfstrasse 15, 81671 München (DE).

[DE/DE]; Müllnerhorngasse 1, 83435 Bad Reichenhall

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/013540

H03H 11/24

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. November 2004 (29.11.2004)

4. Februar 2004 (04.02.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

10 2004 005 531.9

(72) Erfinder; und

Deutsch

(74) Anwälte: KÖRFER, Thomas usw.; Mitscherlich & Partner, Postfach 33 06 09, 80066 München (DE).

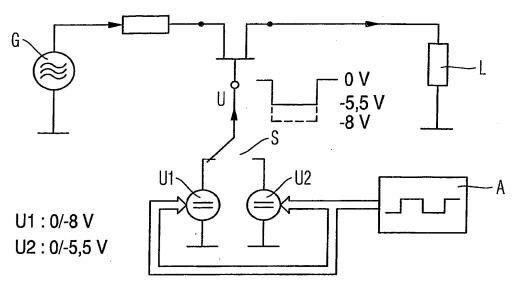
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRAEMER, Wilhelm

(30) Angaben zur Priorität: 103 59 298.9 17. Dezember 2003 (17.12.2003) DE (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRONIC HIGH-FREQUENCY SWITCH AND ATTENUATOR WITH SAID HIGH-FREQUENCY SWITCHES

(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHER HOCHFREQUENZ-SCHALTER UND EICHLEITUNG MIT SOLCHEN HOCHFRE-QUENZ-SCHALTERN



(57) Abstract: The invention relates to an electronic high-frequency switch, comprising a field-effect transistor as switching element, whereby the size of the gate voltage may be switched between at least two values (- 5.5V or -8V), according to the desired linearity or switching speed. The switching device for the gate voltage is preferably coupled to a correction device in which different correction values for transmission or reflection of the high-frequency switch, corresponding to the different gate voltage values are stored.

(57) Zusammenfassung: Bei einem elektronischen Hochfrequenz-Schalter mit einem Feldeffekttransistor als Schaltelement ist die Grösse der Gate-Spannung je nach der gewünschten Linearität oder Schaltgeschwindigkeit zwischen mindestens zwei Werten (-5,5V bzw. -8V) umschaltbar; vorzugsweise ist die Umschalteinrichtung für die Gate-Spannung mit einer Korrektureinrichtung gekoppelt, in welcher für die unterschiedlichen Gate-Spannungswerte entsprechend unterschiedliche Korrekturwerte für Transmission oder Reflexion des Hochfrequenz-Schalters gespeichert sind.

# WO 2005/060096 A1

I COLUL BUXINDI DI COLULO COLUL COLUL COLUL DI DI DI DI BUXIN BUXI

CN, CO, CR, CÚ, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.